

21st Century COE, Nanoelectronics for Tera-bit Information Processing

Hiroshima University

第4回広島国際ワークショップ 「テラビット情報ナノエレクトロニクス」 — 超微細デバイス・プロセス技術 —

日時:平成17年9月16日(金)

場所:広島大学学士会館

プログラム講演題目

- | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9:00-9:10 | 開会の辞 |
| 9:10-9:30 | 牟田泰三学長挨拶 |
| 9:30-9:50 | COE成果報告 広島大学 岩田穆 |
| 9:50-10:30 | 招待講演 慶応大学 黒田忠広
「システムLSI: 挑戦と好機」 |
| 10:30-11:10 | 招待講演 エール大学 T. P. Ma
「将来のCMOS技術のためのHigh-kゲート絶縁膜」 |
| 11:10-11:50 | 招待講演 カリフォルニア大学LA校 J. C. S. Woo
「サブ20nm新規Siペーストランジスタ」 |
| 11:50-13:10 | 昼 食 |
| 13:10-13:50 | 招待講演 IMEC S. Biesemans
「サブ45nm技術のためのスケーリング技術」 |
| 13:50-14:30 | 招待講演 ソウル大学 Y. J. Park
「ナノMOSFETとスケーリング問題のデバイスシミュレーション」 |
| 14:30-15:10 | 招待講演 STマイクロエレクトロニクス F. Boeuf
「45nmノードのための従来型バルクデバイスおよびバルク+アーキテクチャ技術」 |
| 15:10-15:20 | 休 憩 |
| 15:20-16:00 | 招待講演 松下電器 丹羽正昭
「HfベースのPVD High-kゲートスタックの現状 — プロセス改良による駆動電流の向上」 |
| 16:00-16:40 | 広島大学 角南英夫ほか4名
「COEにおけるデバイス・プロセス研究開発の現状」 |
| 16:40-18:00 | 一般発表(ポスター) |
| 18:00 | バンケット |

主催: 広島大学

後援: IEEE広島支部、応用物理学会中国四国支部、
電気通信情報学会中国支部


問合せ先:

広島大学ナノデバイス・システム研究センター
COE事務員 白石絵美

Tel: 082-424-6969 / Fax: 082-424-6969

E-mail: shiraishi@sxsys.hiroshima-u.ac.jp

<http://www.rcis.hiroshima-u.ac.jp/21coe/>



広島大学ナノデバイス・システム研究センター
スーパークリーンルーム (0.1 μ m, クラス10)